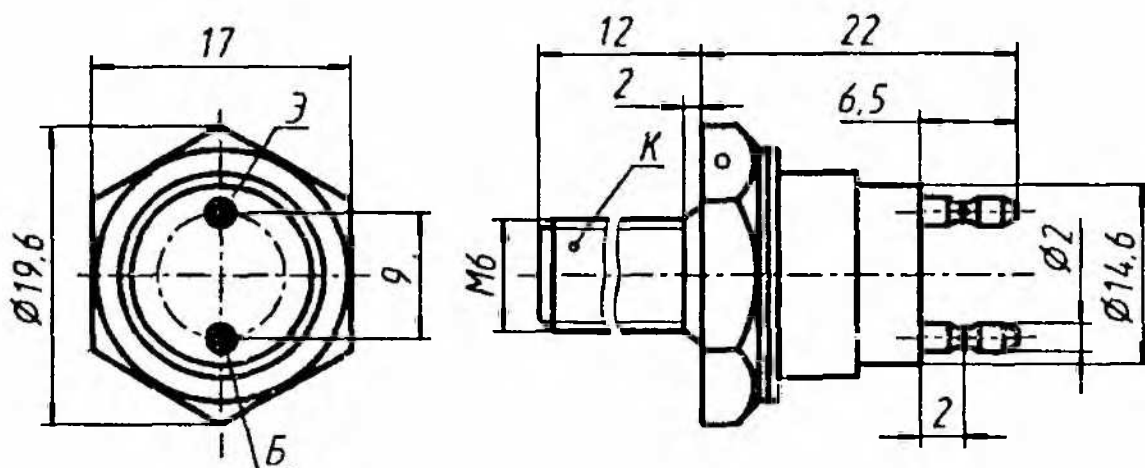


2Т926А, КТ926А, КТ926Б

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *п-р-п* импульсные. Предназначены для применения в импульсных модуляторах. Корпус металлокерамический с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 20 г.

2Т926А, КТ926(А,Б)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при $T_K = +25^\circ\text{C}$:

$U_{КЭ} = 7\text{ В}$, $I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А 12...60

$U_{КЭ} = 7\text{ В}$, $I_K = 15\text{ А}$ для КТ926А 10...60

$U_{КЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 5\text{ А}$ для КТ926Б 10...60

при $T_K = T_{K, \text{макс}}$, $U_{КЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 5\text{ А}$

для КТ926А, КТ926Б, не более 200

при $T_K = T_{K, \text{мин}}$:

$U_{КЭ} = 7\text{ В}$, $I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А 5...60

$U_{КЭ} = 7\text{ В}$, $I_K = 15\text{ А}$ для КТ926А 8...60

$U_{КЭ} = 5\text{ В}$, $I_K = 7\text{ А}$ для КТ926Б 8...60

Отношение статического коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $T_K = +125^\circ\text{C}$ к статическому коэффициенту передачи тока при $T_K = +25^\circ\text{C}$, $U_{КЭ} = 7\text{ В}$, $I_K = 15\text{ А}$ для 2Т926А, не более 3

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{КЭ} = 10\text{ В}$, $I_K = 1\text{ А}$, $f = 30\text{ МГц}$, не менее 1,7

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер:	
при $I_K = 15$ А, $I_B = 3$ А для 2Т926А, КТ926А, не более.....	2,5 В
при $I_K = 15$ А, $I_B = 2$ А для 2Т926А.....	0,4*...0,6*...1 В
при $I_K = 10$ А, $I_B = 1,5$ А для КТ926Б.....	0,5*...2,5 В
Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:	
при $I_K = 15$ А, $I_B = 1,5$ А для 2Т926А, КТ926А.....	2,5 В
при $I_K = 10$ А, $I_B = 1,5$ А для КТ926Б.....	2,5 В
Обратный ток коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 10$ Ом:	
при $T_K = T_{K, \text{мин}}...+25$ °С, $U_{КЭ} = 150$ В.....	0,1*...25 мА
при $T_K = T_{K, \text{макс}}$, $U_{КЭ} = 120$ В.....	0,2*...80 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 5$ В, не более.....	
	300 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ¹ при $T_n \leq 100$ °С, $R_{БЭ} = 10$ Ом.....		150 В
Импульсное напряжение коллектор—эмиттер при $t_n \leq 0,5$ мс, $Q \geq 50$, $R_{БЭ} = 10$ Ом.....		200 В
Постоянное напряжение база—эмиттер.....		5 В
Постоянный ток коллектора.....		15 А
Импульсный ток коллектора при $t_n \leq 0,5$ мс, $Q \geq 50$		25 А
Постоянный ток базы.....		7 А
Импульсный ток базы при $t_n \leq 0,5$ мс, $Q \geq 50$		12 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора ² при $T_K = T_{K, \text{мин}}...+50$ °С.....		50 Вт
Импульсная рассеиваемая мощность кол- лектора 2Т926А при $t_n \leq 0,5$ мс, $Q \geq 50$, $T_K = +25...+80$ °С.....		450 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус при $U_{КЭ} \leq 10$ В, $I_K \leq 5$ А.....		2 °С/Вт
Температура р-п перехода.....		+150 °С
Температура корпуса.....		+125 °С

¹ При $T_n = +100...150$ °С $U_{КЭ, \text{макс}}$ уменьшается линейно на 10% на каждые 10 °С.

² При $T_K > +50$ °С

$$P_{K, \text{макс}} = (T_n - T_K) / R_{T(n-K)}, \text{ Вт},$$

где $R_{T(n-K)}$ определяется из области максимальных режимов например, при $U_{КЭ} = 10$ В, $I_K = 5$ А $R_{T(n-K)} \approx 2$ °С/Вт).

Температура окружающей среды:

2Т926А	$-60... T_K =$ $= +125\text{ }^{\circ}\text{C}$
КТ926А, КТ926Б	$-45... T_K =$ $= +100\text{ }^{\circ}\text{C}$

При конструировании аппаратуры следует учитывать возможность самовозбуждения транзисторов за счет паразитных связей. Крепление транзисторов к панели необходимо осуществлять с помощью гайки. Осевое усилие на винт должно быть не более 120 кг. Допускается распайка транзисторов паяльником с температурой $+275\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 3 с не ближе 2 мм от корпуса.